

## SOT- 23塑封装晶体管

**S8550** 晶体管 ( PNP )

特点

免费为S8050

集电极电流:  $I_c = 0.5A$

标记: 2TY

最大额定值 (  $T_c = 25^\circ C$  除非另有说明 )



符号	参数	价值	单位
$V_{CB0}$	集电极 - 基极电压	-40	V
$V_{CE0}$	集电极 - 发射极电压	-25	V
$V_{EB0}$	发射极 - 基极电压	-5	V
$I_c$	集电极电流 - 连续	-0.5	A
$P_c$	集电极耗散功率	0.3	W
$T_j$	结温	150	$^\circ C$
$T_{存储}$	储存温度	-55-150	$^\circ C$

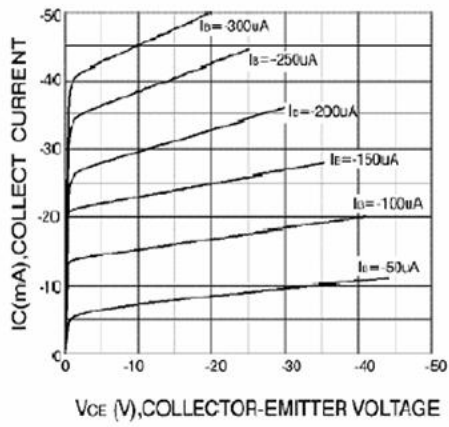
电气特性 ( 除非另有规定环境温度  $T_{amb} = 25^\circ C$  )

参数	符号	TEST 条件	民	最大	单位
集电极 - 基极击穿电压	$V_{(BR)CB0}$	$I_c = -100 \mu A, I_E = 0$	-40		V
集电极 - 发射极击穿电压	$V_{(BR)CE0}$	$I_c = -1mA, I_E = 0$	-25		V
发射极 - 基极击穿电压	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = -100 \mu A, I_c = 0$	-5		V
集电极截止电流	$I_{CB0}$	$V_{CB} = -40V, I_E = 0$		-0.1	$\mu A$
集电极截止电流	$I_{CE0}$	$V_{CE} = -20V, I_E = 0$		-0.1	$\mu A$
发射极截止电流	$I_{EB0}$	$V_{EB} = -3V, I_c = 0$		-0.1	$\mu A$
直流电流增益	$h_{FE(1)}$	$V_{CE} = -1V, I_c = -50mA$	120	400	
	$h_{FE(2)}$	$V_{CE} = -1V, I_c = -500mA$	50		
集电极 - 发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	$I_c = -500mA, I_E = -50mA$		-0.6	V
基射极饱和电压	$V_{BE(SAT)}$	$I_c = -500mA, I_E = -50mA$		-1.2	V
跃迁频率	$f_T$	$V_{CE} = -6V, I_c = -20mA$ $f = 30MHz$	150		兆赫

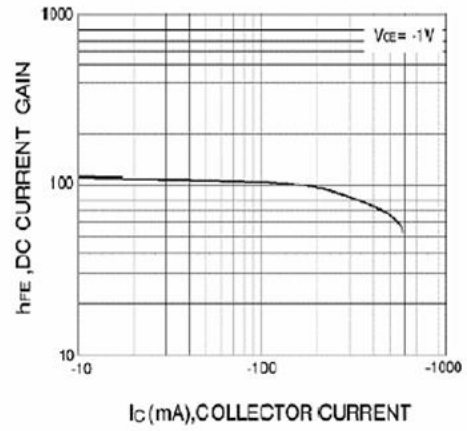
分类 $h_{FE(1)}$		
秩	L	H
范围	120-200	200-350

典型特征

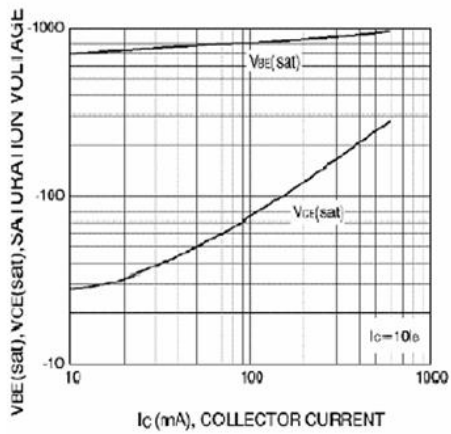
S8550



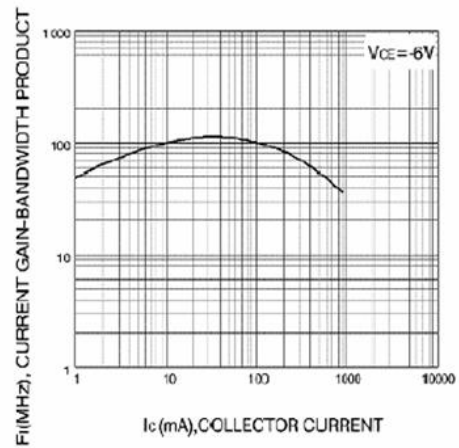
Static Characteristic



DC current Gain



Base-Emitter Saturation Voltage  
Collector-Emitter Saturation Voltage



Current Gain Bandwidth Product